

Si-Leistungs-Z-Dioden
Кремниевые мощные стабилитроны
Si-power-Z-diodes

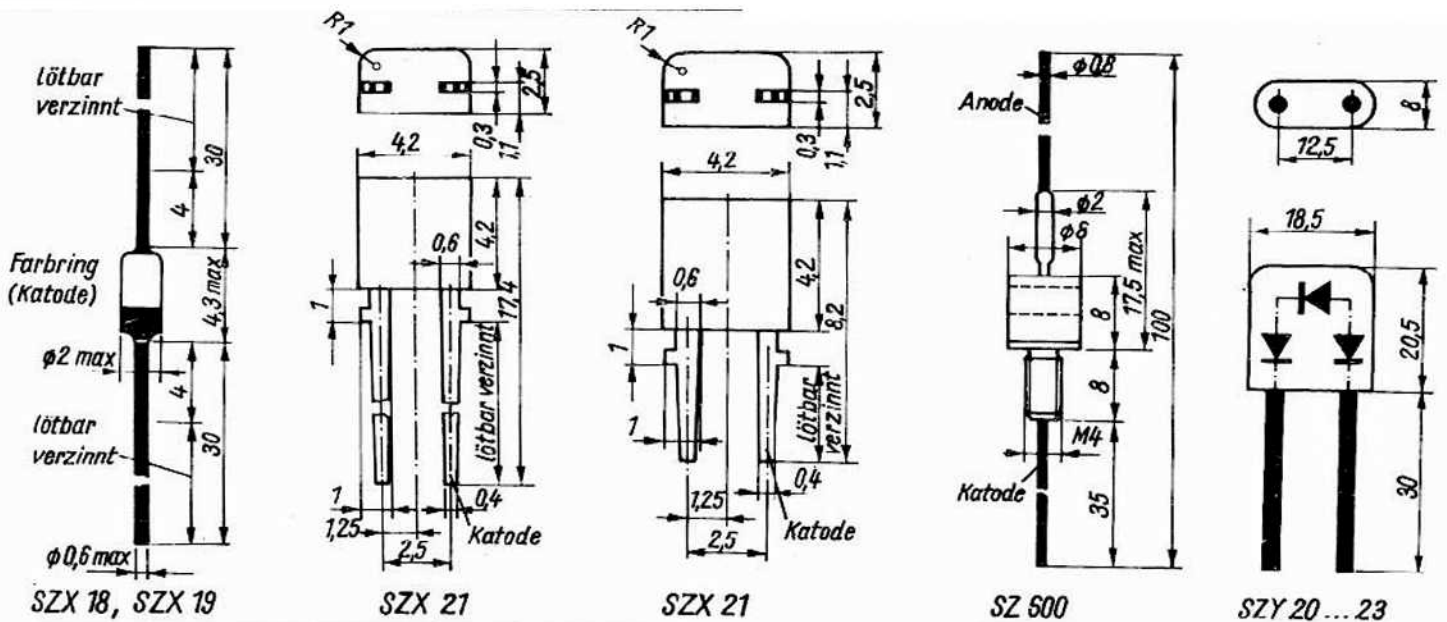
Typ

Kennwerte bei $\Phi_a = 25^\circ\text{C}$

Typ	P_{tot}	I_Z	$I_Z^{2)}$	I_F	U_Z	r_Z	bei			R_{thi} R_{th}^* grd/W
							I_Z	$T_{K_{UZ}}$	$10^{-4}/\text{grd}$	
W	mA	mA	mA	V	Ω	mA	$10^{-4}/\text{grd}$			
SZ 600/0,75 ¹⁾		1000	3000		0,65...0,85	0,5	100	-		
SZ 600/5,1		180	1450		4,8 ... 5,4	2	100	-1		
SZ 600/5,6		165	1330		5,2...6,0	1	100	+2		
SZ 600/6,2		150	1210		5,8 ... 6,6	1	100	+3		
SZ 600/6,8		135	1100		6,4 ... 7,2	1	100	+3		
SZ 600/7,5		125	1010		7,0 ... 7,9	1	100	+4		
SZ 600/8,2		115	910		7,7 ... 8,7	1	100	+5		
SZ 600/9,1	1	105	830		8,5 ... 9,6	2	50	+6		
SZ 600/10	8 ²⁾	95	750	100	9,4 ... 10,6	2	50	+6		<8
SZ 600/11		85	690		10,4...11,6	4	50	+7		<80*
SZ 600/12		80	630		11,4...12,7	4	50	+7		
SZ 600/13		70	570		12,4...14,1	5	50	+7		
SZ 600/15		65	500		13,8...15,6	5	50	+7		
SZ 600/16		60	470		15,3...17,1	6	25	+7		
SZ 600/18		55	420		16,8...19,1	6	25	+7		
SZ 600/20		50	380		18,8...21,2	6	25	+8		
SZ 600/22		45	350		20,8...20,3	6	25	+8		

1) in Flußrichtung gepolte Diode

2) $\Phi_c = 25^\circ\text{C}$



Kurzzzeichen

A	wirksame Fläche	I_Z	Z-Strom	U_{CESat}	Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
C_c	Gehäusekapazität	ΔI_Z	Stabilität des Z-Stroms	U_{CEV}	Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei in Sperrrichtung vorge- spannter Emitterdiode
C_{gss}	Eingangskapazität	I_O	Ausgangsstrom	U_D	Blockierspannung
C_j	Sperrschichtkapazität	I_O	Richtstrom	U_{DB}	Drain-Bulk-Spannung
C_L	Lastkapazität	ΔI_O	Richtstromdifferenz	U_{DG}	Drain-Gate-Spannung
C_{tot}	Gesamtkapazität	l	Länge	U_{DM}	Scheitelblockier- spannung
CMR	Gleichtaktunter- drückung	L	Leuchtdichte	$\hat{U}_{DR}$	Periodische Spitzen- blockierspannung
$d_{\dot{u}}$	Übertragungsdämpfung	L_S	Serieninduktivität	$\hat{U}_{DS}$	Nichtperiodische Spitzenblockierspannung
E	Beleuchtungsstärke	N_O	Ausgangslastfaktor	U_{DS}	Drain-Source-Spannung
F	Rauschfaktor	P_{in}	HF-Eingangsleistung	U_e	Eingangsspannung
f	Frequenz	P_{RS}	Nichtperiodische Sperrverlustleistung	U_{EBO}	Emitter-Basis-Sperr- spannung
f_{h21b}	Grenzfrequenz in Basisschaltung	P_{tot}	Totale Verlustleistung	U_F	Durchlaßgleichspannung
f_{h21e}	Grenzfrequenz in Emitterschaltung	$R_{\dot{a}q}$	Äquivalentwiderstand	U_{GB}	Gate-Bulk-Spannung
f_Q	Gütegrenzfrequenz	R_{BE}	Basis-Emitter-Wider- stand	U_{GS}	Gate-Source-Spannung
f_T	Transitgrenzfrequenz	R_{DS}	Drain-Source-Widerstand	U_{GT}	Zündspannung
G_{pb}	HF-Leistungsverstärkung in Basisschaltung	R_e	Eingangswiderstand	U_{HF}	HF-Spannung
h	Höhe	R_g	Generatorwiderstand	U_I	Gleichtakteingangs- spannung
h_{21E}	Gleichstromverstärkung	R_L	Lastwiderstand	U_{ID}	Differenzeingangs- spannung
h_{21e}	Kurzschlußstromverstär- kung in Emitterschaltung	R_{th}	Gesamtwärmewiderstand	U_{IO}	Eingangsoffsetspannung
I_B	Basisstrom	R_{thi}	Innerer Wärmewiderstand	U_R	Sperrspannung, Sperrgleichspannung
I_C	Kollektorstrom	r_F	Durchlaßwiderstand	U_{RM}	Scheitelsperrspannung
I_{CBO}	Kollektorreststrom bei offenem Emitter	r_R	Sperrwiderstand	$\hat{U}_{RR}$	Periodische Spitzen- sperrspannung
I_{CES}	Kollektor-Emitter- Reststrom	r_Z	Z-Widerstand	$\hat{U}_{RS}$	Nichtperiodische Spitzenperrspannung
I_{CEV}	Kollektorreststrom bei in Sperrrichtung vorge- spannter Emitterdiode	S	Empfindlichkeit	U_S	Betriebsspannung
I_D	Drainstrom	t_{DHL}	Einschaltverzögerungs- zeit	U_{SB}	Source-Bulk-Spannung
I_D	Blockierstrom	t_{DLH}	Ausschaltverzögerungs- zeit	U_T	Schwellspannung
$\hat{I}_{DR}$	Drainspitzenstrom	t_{gt}	Zündzeit	U_Z	Z-Spannung
I_e	Strahlstärke	t_{off}	Ausschaltzeit	ΔU_Z	Stabilität der Z-Spannung
I_F	Flußstrom, Durchlaß- gleichstrom	t_{on}	Einschaltzeit	U_{OH}	High-Ausgangsspannung
$\bar{I}_F$	Dauergrenzstrom	t_q	Freiwerdzeit	U_{OL}	Low-Ausgangsspannung
$\bar{I}_F$	Effektiver Durchlaß- strom	t_r	Anstiegzeit	V_U	Spannungsverstärkung
I_{FM}	Scheiteldurchlaßstrom	t_{rr}	Sperrerholungszeit	Y_{21}	Steilheit
I_{FN}	Nenndurchlaßstrom, Nenngleichstrom	t_s	Speicherzeit	ϑ_a	Umgebungstemperatur
$\hat{I}_{FR}$	Periodischer Spitzen- strom	TK_{UZ}	Temperaturkoeffizient der Z-Spannung	ϑ_c	Gehäusetemperatur
$\hat{I}_{FS}$	Nichtperiodischer Spitzenstrom	U_{AN}	Nennanschlußspannung (Effektivwert)	ϑ_j	Sperrschichttemperatur
I_{GT}	Zündstrom	U_{BE}	Basis-Emitter-Spannung	$\Delta \vartheta$	Temperaturdifferenz
I_H	Haltestrom	$U_{(BR)}$	Durchbruchspannung	λ	Emissionswellenlänge
I_I	Eingangsbiassstrom	U_{CB}	Kollektor-Basis- Spannung	λ_p	Wellenlänge maximaler Emission
I_{IO}	Eingangsoffsetstrom	U_{CBO}	Kollektor-Basis- Sperrspannung	$\Delta \lambda$	Spektrale Halbwerts- breite
I_R	Sperrstrom	U_{CE}	Kollektor-Emitter- Spannung	τ_i	Einschaltzeitkonstante
I_T	Durchlaßstrom	U_{CEO}	Kollektor-Emitter- Sperrspannung bei offener Basis		
$\bar{I}_T$	Dauergrenzstrom	U_{CER}	Kollektor-Emitter- Sperrspannung bei end- lichem Basis-Emitter- Widerstand		
$\bar{I}_T$	Effektiver Durchlaßstrom	U_{CERest}	Kollektorrestspannung		
$\hat{I}_{TR}$	Periodischer Spitzen- strom	U_{CES}	Kollektorsperrspannung bei kurzgeschlossenem Emitterdiode		